		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.	NY4. 11.03.03.21.73.14.001		Конденсаторы		
		<i>C1</i>	K78-630B-1mκΦ±10%	1	
		<i>C2, C3, C9</i>	K78-630B-0,1mkΦ±10%	3	
		C4, C5	K50-63B-470mkΦ±10%	2	
		<i>[6</i>	K50-63B-22mκΦ±5%	1	
		<i> </i>	K78–630B–47nΦ±5%	2	
Справ. №					
			<u>Резисторы</u>		
		R1	C2–33H–0,125Bm–22к0м±5%	1	
		R2	C2–33H–0,125Bm–2,2к0м±5%	1	
		R3	С2–33H–0,125Bm–5600м±5%	1	
		R4	C2–33H–0,125Bm–18к0м±5%	1	
		R5	C2–33H–0,125Bm–1к0м±5%	1	
	•	R6	C2-33H-0,125Bm-27к0м±5%	1	
Подп. и дата		R7	C2-33H-0,125Bm-4,7к0м±5%	1	
		R8	Резистор переменный 3296W-1-101 (Bourns, CWA)	1	
		R9, R10	С2–33H–0,125Bm–2200м±5%	2	
		R11, R12	С2–33H–2Bm–0,10м±5%	2	
		R13	С2–33H–1Bm–100м±5%	1	
инв. № Инв. № дубл.			<u>Транзисторы</u>		
		VT1, VT2	2N54O1 (ON Semiconductor, США)	2	
		VT3, VT5	BD139G (ON Semiconductor, США)	2	
		VT4	MJE15032G (ON Semiconductor, США)	1	
		VT6	BD14OG (ON Semiconductor, США)	1	
Взам. 1		VT7	TIP36CG (ON Semiconductor, США)		
B		VT8	TIP35CG (ON Semiconductor, США)	1	
סשו					
. и дата					
Подп.		May Austr		ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭЗ	
Инв. № подл.	_	Изм. Лист Разраб.	<i>№ докум.</i> Подп. Дата Круглов В. С.		Лит. Лист Листов
			Геливанов К. В. УМЗЧ на биполярных транзисторах		1 2
		Н. контр.	Спецификация		МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Групра ИУ. 735
		Утв.	Konunahaa		Группа ИУ4-73Б Фппмпт Д.С

Копировал

Формат

		Поз. обозначение	Наименование	Кал.	Примечание
Перв. примен.	14.001		<u>Разъёмы</u>		
	3.21.73.	XS1	тісго-fit 3.0 430450821 (Molex, США)	1	
	NY4, 11,03,03,21,73,14,001	XS2, XS3	ACJS-MH (Amphenol, США)	2	
			Радиатор охлаждения HS 107–30	2	
Н					
Справ. №					
ווום					
. и дата					
Подп.					
Инв. № дубл.					
1HB. Nº					
Н					
инв. №					
Взам. і					
7					
и дата					
7D. U.C					
Подп.					
IJ,					
Инв. № подл.		<u> </u>			O4 FIDE Aucm
MHB. 1		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	ИУ4.11.03.03.21.73.14.001 ПЭЗ	
		VISITI. / IULIII	N° ийкум. Пийн. диши Копировал		Формат А4